

등록번호 97-72358 1/2

① 대 한 민 국 특 허 청 (KR)
 ② 공 개 특 허 공 보 (A)

③ In. Cl.
 II 01 L 29/50

제 2658 호

④ 공개일자 1997. 11. 7
 ⑤ 출원일자 1996. 4. 1

⑥ 공개번호 97-72358

⑦ 출원번호 96-9774

심사청구: 있음

⑧ 발 명 사 항 명 족 경기도 성남시 분당구 수내동 55 드레이퍼드 132-1504

⑨ 출 원 인 아남산업 주식회사 대표이사 차 인 선

서울특별시 성동구 성수 2가 280-8 (우: 133-120)

⑩ 대리인 범리사 서 만 규

(전 2면)

⑪ 반도체패키지의 제조방법 및 구조

⑫ 요 약

본 발명은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도체장치의 저연을 외부로 노출시켜 회로통과시
 발생되는 열단승의 효과를 극복하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 향상시킬目的로, 패키지의 용병
 부 외측에 위치한 티드는 절단하고, 절단부 내측에 위치한 티드는 그 저연을 외부로 노출시켜 마더보드에 실장
 시 티드의 저연에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장전체를 최소화할 수 있는 반도체패키지이다.

도하설구의 범위

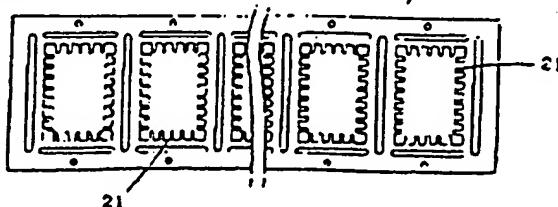
1. 리스의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중 일부에는 침입재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리드 중 일부에 반도체침을 위치시켜 와이어본딩을 실시하는 단계와: 상기 와이어본딩된 리드, 반도체침 및 와이어를 외부의 산화 및 부식으로부터 보호하기 위하여 물딩하는 단계와: 상기 단계 후에 물딩영역의 외각에 위치한 리드를 절단하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
2. 제1항에 있어서, 상기 와이어본딩은 배줄 (ValleyWire Hole)이 형성된 허디볼락에 반도체침을 위치시켜 상기 배줄 둘로 공기를 떨어들여 반도체침을 치자 고정하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
3. 제1항에 있어서, 상기 물딩단자는 예상 물지재를 사용하여 물딩하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
4. 제1항 또는 3항에 있어서, 예상 물지재를 사용하여 물딩하기 전에 물딩영역에 맷돌 형성하여 예상 물지재가 둘러 날리는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
5. 제1항에 있어서, 상기 물딩단자는 물드 경과온드를 사용하여 물딩하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
6. 제3항 또는 5항에 있어서, 상기 예상 물지재 및 물드 경과온드로 물딩 후, 150°C 이상의 고온에서 수시진 노출시켜 경화시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
7. 제1항에 있어서, 상기 반도체제작기지의 저연에는 그라인드 (Grind)를 실시하여 플래시 (Flash)를 제거하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
8. 제1항에 있어서, 상기 물딩영역의 외각에 위치한 리드를 절단시 절단을 용이하게 하기 위하여 절단되는 부위의 리드에 노치 (Notch)를 형성하는 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
9. 저연이 외부로 직접 노출되는 반도체침과: 상기 반도체침의 외측에 위치되고 물딩영역을 빛나지 않으며 저연이 외부로 노출되어 저연에서 신호의 일출이 이루어지는 다수의 리드와: 상기 반도체침과 리드를 연결시켜주는 와이어와: 상기 반도체침, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 물딩된 예상 물지재 또는 경과온드로 구성된 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
10. 제9항에 있어서, 상기 물딩된 예상 물지재 및 경과온드는 리드 및 반도체침의 상부로만 물딩된 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
11. 제9항에 있어서, 상기 반도체제작기지의 저연에는 플래시 (Flash)의 제거를 위해 그라인드 (Grind) 된 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
12. 제9항에 있어서, 리드프레임의 다수의 리드 중 일부에는 침입재판이 없는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.

* 참고사항: 제조출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

제2도는 본 발명에 적용되는 리드프레임을 도시한 평면도.

제 2 도



① 대 한 민 국 특 허 청 (KR)
② 공 개 특 허 공 보 (A)

③ InL Cl.
II 01 L 23/50

제 2658 호

④ 등기일자 1997. 11. 7
⑤ 출원일자 1996. 4. 1

⑥ 공개번호 97-72358

⑦ 출원번호 96-9774

심사청구 : 있음

⑧ 발 명 자 허 명 을 경기도 성남시 분당구 수내동 55 드레이파드 132-1504

⑨ 출 원 인 아남산업 주식회사 대표이사 왕 인 선

서울특별시 성동구 성수 2가 280-8 (우: 133-120)

⑩ 대리인 변리사 서 만 규

(전 2면)

◎ 반도체패키지의 제조방법 및 구조

◎ 요 악

본 발명은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로 반도체칩의 저연을 외부로 노출시켜 피드통착시
발생되는 열단순의 효과를 극대화하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 향상시킬은 물론, 패키지의 품질
부 외측에 위치한 티드는 절단하고, 풀립부 내측에 위치한 티드는 그 저연을 외부로 노출시켜 마더보드에 실착
시 티드의 저연에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장연적을 최소할 수 있는 반도체패키지이다.

도면구의 범위

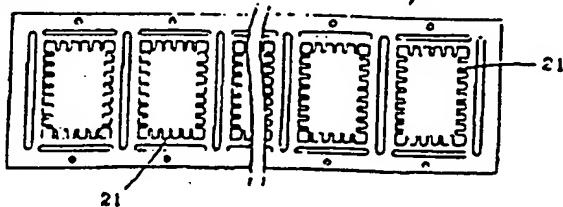
1. 디수의 리드가 형성되고, 상기 디수의 리드 중 일부에는 침입재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와; 상기 리드프레임의 디수의 리드 중 일부에 반도체칩을 위치시켜 와이어본딩을 실시하는 단계와; 상기 와이어본딩된 리드, 반도체칩 및 와이어를 외부의 신호 및 부식스도부터 보호하기 위하여 물딩하는 단계와; 상기 단계 후에 물딩영역 외각에 위치한 리드를 철단하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
2. 저1항에 있어서, 상기 와이어본딩후 배출 흙(Vacuum Hole)이 형성된 허디플렉에 반도체칩을 위치시켜 상기 배출 흙도 공기로 공기를 밀어들여 반도체칩을 치자고정하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
3. 저1항에 있어서, 상기 물딩단자는 액상봉지재를 사용하여 물딩하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
4. 저1항 또는 3항에 있어서, 액상봉지재를 사용하여 물딩하기 전에 물딩영역에 물을 형성하여 액상봉지재가 물에 냉착되는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
5. 저1항에 있어서, 상기 물딩단자는 물드컴파운드를 사용하여 물딩하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
6. 저3항 또는 5항에 있어서, 상기 액상봉지재 및 물드컴파운드로 물명 후, 150°C 이상의 고온에서 수시진 노광시켜 정화시키는 증정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
7. 저1항에 있어서, 상기 반도체패키지의 저면에는 그라인드(Grind)를 실시하여 플래시(Flash)을 제거하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
8. 저1항에 있어서, 상기 물딩영역의 외각에 위치한 리드를 철단시 철단을 용이하게 하기 위하여 철단되는 부위의 리드에 노치(Notch)를 형성한 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
9. 저1항에 있어서, 상기 물딩단자는 물드컴파운드로 물명 후, 150°C 이상의 고온에서 수시진 노광시켜 정화시키는 증정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.
10. 저9항에 있어서, 상기 물딩된 액상봉지재 및 물드컴파운드는 리드 및 반도체칩의 상부로만 물딩된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.
11. 저9항에 있어서, 상기 반도체패키지의 저면에는 물제식(Flash)의 제거를 위해 그라인드(Grind)된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.
12. 저9항에 있어서, 디드프레임의 나수의 리드 중앙부에는 침입재판이 없는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

※ 참고사항: 저작권법 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

서2도는 본 실명에 적용되는 리드프레임을 도시한 평면도.

제2도



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl. *

H01L 23 /50

(21) 출원번호 특 1996-0009774

(22) 출원일자 1996년 04월 01일

(71) 출원인 아남신업 주식회사 황인길

(72) 발명자 서울특별시 성동구 성수 2기 280-8 (우 : 133-120)
허영욱(74) 대리인 경기도 성남시 분당구 수내동 55 콧데이파트 132-1504
서안규

설명부 : 있음

(54) 반도체패키지의 제조방법 및 구조

요약

본 발명은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도체칩의 저연율 외부로 노출시켜 회로동작시 발생되는 열 방출의 효과를 극대화하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 향상시킴은 물론 패키지의 물당부 외측에 위치한 리드는 절단하고, 물당부 내측에 위치한 리드는 그 저연율 외부로 노출시켜 마더보드에 실장시 리드의 저연에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소할 수 있는 반도체패키지이다.

대표도

도2

연세서

[발명의 명칭]

반도체패키지의 제조방법 및 구조

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명에 적용되는 리드프레임을 도시한 평면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(5) 청구의 범위

청구항 1. 다수의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙부에는 침탈재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와; 상기 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에 반도체칩을 위치시켜 와이어본딩을 실시하는 단계와; 상기 와이어본딩된 리드, 반도체칩 및 와이어를 외부의 산화 및 부식으로부터 보호하기 위하여 울당하는 단계와; 상기 단계후에 울당영역 외각에 위치한 리드를 절단하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 와이어본딩은 배콤 흙(vacuum Hole)이 형성된 하터블럭에 반도체칩을 위치시켜 상기 배콤 흙으로 공기흡 받아들여 반도체칩을 지지 고정하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 울당단계는 액상 봉지재를 사용하여 울당하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 4. 제1항 또는 3항에 있어서, 액상 봉지재를 사용하여 울당하기 전에 울당영역에 담을 형성하여 액상 봉지재가 울려 넘치는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 울당단계는 올드 컴파운드를 사용하여 울당하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 6. 제3항 또는 5항에 있어서, 상기 액상 봉지재 및 올드 컴파운드로 울당 후, 150°C 이상의 고온에서 수시간 노출시켜 경화시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 7. 제1항에 있어서, 상기 반도체패키지의 저연에는 그라인드(Grind)를 실시하여 플래시(Flash)를 제거하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 8. 제1항에 있어서, 상기 울당영역의 외각에 위치한 리드를 절단시 절단을 용이하게 하기 위하여 절단되는 부위의 리드에 노치(Notch)를 형성함을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 9. 저연이 외부로 직접 노출되는 반도체칩과; 상기 반도체칩의 외측에 위치되고 울당영역을 벗어나지 않으며 저연이 외부로 노출되어 저연에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드와; 상기 반도체칩과 리드를 연결시켜주는 와이어와; 상기 반도체칩, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 울당된 액상 봉지재 또는 컴파운드로 구성된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

청구항 10. 제9항에 있어서, 상기 울당된 액상 봉지재 및 컴파운드는 리드 및 반도체칩의 상부로만 울당된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

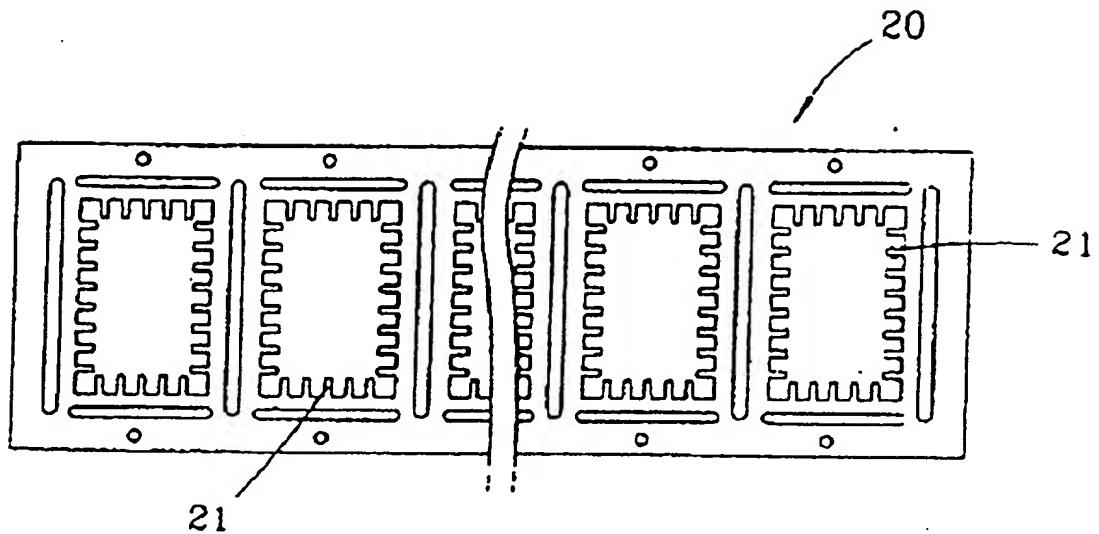
청구항 11. 제9항에 있어서, 상기 반도체패키지의 저연에는 플래시(Flash)의 제거를 위해 그라인드(Grind)된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

청구항 12. 제9항에 있어서, 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에는 침탈재판이 없는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

* 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

541

542



등록번호 97-72358 1/2

① 대 한 민 국 특 허 청 (KR)
 ② 공 개 특 허 공 보 (A)

③ Int Cl.
 II 01 L 23/50

제 2658 호

④ 공개일자 1997. 11. 7
 ⑤ 출원일자 1996. 4. 1

⑥ 공개번호 97-72358

⑦ 출원번호 96- 9774

실사청구: 있음

⑧ 발 명 자 허 명 우 경기도 성남시 분당구 수내동 55 드레이퍼드 132- 1504

⑨ 출 원 인 아남산업 주식회사 대표이사 최 인 실

서울특별시 송파구 성수 2가 280-8 (우: 133-120)

⑩ 대리인 변리사 서 만 규

(전 2인)

⑪ 반도체패키지의 제조방법 및 구조

⑫ 요 약

본 발명은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도체칩의 저연을 외부로 노출시켜 외부통작시 발생되는 열압출의 효과를 극대화하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 향상시킬은 물론, 패키지의 용량부 외측에 위치한 티드는 것과하고 중앙부 내측에 위치한 티드는 그 저연을 외부로 노출시켜 마더보드에 실장사 티드의 저연에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장전체를 띠 수 있는 반도체패키시이다.

특허설구의 범위

1. 다수의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중 일부에는 침입재판이 없는 리드프레임을 형성하는 반제와; 상기 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에 반도체침을 위치시켜 와이어본딩을 실시하는 단계와; 상기 와이어본딩된 리드, 반도체침 및 와이어를 외부의 신호 및 부식으로부터 보호하기 위하여 물딩하는 단계와; 상기 단계 후에 물딩영역 외각에 위치한 리드를 결단하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
2. 제1항에 있어서, 상기 와이어본딩은 배출 홀(Neasurement Hole)이 형성된 허디볼트에 반도체침을 위치시켜 상기 배출 홀로 긍기기를 빌어들여 반도체침을 치자고정하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
3. 제1항에 있어서, 상기 물딩단계는 예상 물지재를 사용하여 물딩하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
4. 제1항 또는 3항에 있어서, 예상 물지재를 사용하여 물딩하기 전에 물딩영역에 물을 형성하여 예상 물지재가 물에 녹는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
5. 제1항에 있어서, 상기 물딩단계는 물드 침파운드를 사용하여 물딩하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
6. 제3항 또는 5항에 있어서, 상기 예상 물지재 및 물드 침파운드로 물딩 후, 150°C 이상의 고온에서 수시진 노출시켜 경화시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
7. 제1항에 있어서, 상기 반도체제작기지의 저연에는 그라인드(Grind)를 실시하여 플래시(Flash)를 제거하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
8. 제1항에 있어서, 상기 물딩영역의 외각에 위치한 리드를 결단시 결단을 용이하게 하기 위하여 결단되는 부위의 리드에 노치(Notch)를 형성하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
9. 저연이 외부로 직접 노출되는 반도체침과; 상기 반도체침의 외측에 위치되고 물딩영역을 벗어나지 않으며 저연이 외부로 노출되어 저연에서 신호의 임금률이 이루어지는 다수의 리드와; 상기 반도체침과 리드를 연결시켜주는 와이어와; 상기 반도체침, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 물딩된 예상 물지재 또는 침파운드를 구성하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
10. 제9항에 있어서, 상기 물딩된 예상 물지재 및 침파운드는 리드 및 반도체침의 상부로만 물딩된 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
11. 제9항에 있어서, 상기 반도체제작기지의 저연에는 플래시(Flash)의 제거를 위해 그라인드(Grind)된 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
12. 제9항에 있어서, 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에는 침입재판이 없는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.

※ 참고사항: 제조출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
도면의 간단한 설명

제2도는 본 발명에 적용되는 리드프레임을 도시한 평면도.

제 2 도

